

Сведения о научном руководителе Ширяева А.А. по диссертации «Прогнозирование дозовой радиационной стойкости КМОП-микросхем на основе анализа вольт-амперных характеристик слоев диоксида кремния», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.2.8 – Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды

Фамилия Имя Отчество официального научного руководителя	Воротынцев Владимир Михайлович
Шифр и наименование специальности, по которой защищена диссертация	1.4.4 Физическая химия
Ученая степень	Доктор химических наук
Ученое звание	Профессор
Место работы	В настоящее время не работает
Почтовый индекс, адрес	603009, г. Нижний Новгород, ул. Пятигорская, д.1, кв. 46
Телефон	+79036062173
Адрес электронной почты	vlad@vorotyn.nnov.ru
Список основных публикаций официального научного руководителя по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет	
<p>1. Метод диагностики радиационной чувствительности слоев диоксида кремния в КМОП-микросхемах на основе анализа вольтамперных характеристик / А.А. Ширяев, В.М. Воротынцев, Е.Л. Шоболов // Датчики и системы. – 2023. – № 1. – С. 11-15.</p> <p>2. Моделирование дозовой радиационной стойкости МОП-транзисторов по результатам контроля тока утечки подзатворного оксида / А.А. Ширяев, В.М. Воротынцев, Е.Л. Шоболов // Датчики и системы. – 2023. – № 5. – С. 49-52.</p> <p>3. Эффект Пула-Френкеля и возможность его применения для прогнозирования радиационного накопления заряда в термическом диоксиде кремния / А.А. Ширяев, В.М. Воротынцев, Е.Л. Шоболов // Физика и техника полупроводников. – 2018. – Т. 52, Вып. 9. – С. 990-994.</p> <p>4. Прогнозирование величины захваченного заряда в захороненном оксиде кремния структур кремний-на-изоляторе с применением эффекта Пула-Френкеля / А.А. Ширяев, В.М. Воротынцев, Е.Л. Шоболов // Физика и техника полупроводников. – 2020. – Т. 54, Вып. 5. – С. 441-445.</p> <p>5. Применение эффекта Пула-Френкеля и инъекции носителей заряда для исследования дефектности термического диоксида кремния / А.А. Ширяев, В.М. Воротынцев, Е.Л. Шоболов // Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. – 2019. – Вып. 3 (254). – С. 29-37.</p>	

6. Влияние электромагнитных помех и режима измерений на ток утечки подзатворного диэлектрика МОП-транзисторов / А.А. Ширяев, В.М. Воротынцев, Е.Л. Шоболов // Технологии электромагнитной совместимости. – 2023. – № 4(87) – С. 80-84.

7. Structural and optical properties of gallium sulfide thin films obtained by plasma-enhanced chemical vapor deposition / L.A. Mochalov, M.A. Kudryashov, V.M. Vorotyntsev, et al. // Photonics Russia. – 2023. – N. 17(2). – P. 96-106.

8. Preparing thin gallium sulfide films via PECVD and studying their properties / L.A. Mochalov, M.A. Kudryashov, V.M. Vorotyntsev, et al. // Russian journal of physical chemistry. – 2023. – N. 97(1). – P. 241-247.

9. Synthesis of gallium oxide via interaction of gallium with iodide pentoxide in plasma / L.A. Mochalov, A. Logunov, V.M. Vorotyntsev, et al. // Optical and quantum electronics. – 2020. – N. 52(510). – P. 1-13.

10. Effect of the substrate surface roughness on the stability of the parameters of thin-film resistive elements / V.E. Sergeev, V.M. Vorotyntsev, T. Sazanova, et al. // Journal of surface investigation X-ray synchrotron and neutron techniques. – 2020. – N. 14(5). – P. 875-881.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Белов Ю.Г.